

Infineons wichtige Ereignisse im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2005

Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket

- Im Februar 2005 hat Infineon bekannt gegeben, dass mit dem Bau einer neuen Frontend-Fertigungsanlage in Kulim, Malaysia, begonnen wurde. Dort sollen hauptsächlich Leistungshalbleiter für die Automobil- und Industrieelektronik produziert werden.
- Das Unternehmen hat sein CoolMOS™-Produktportfolio durch eine neue Serie von Leistungstransistoren erweitert. Diese sind für Stromversorgungen in Computer-Servern und anderen Anwendungen mit hoher Leistungsdichte (z. B. Telekommunikationsanlagen und Flachbildschirme) konzipiert.
- Infineon hat das gemeinsam mit Giesecke & Devrient entwickelte Herstellungsverfahren „Flip Chip On Substrate“ (FCOS) für Chipkartengehäuse vorgestellt, das die Widerstandsfähigkeit der Gehäuse weiter steigert.
- Infineon hat seine Produktpalette von Mikrocontrollern erweitert, darunter zwei 32-Bit Mikrocontroller auf Basis der TriCore™ Architektur und eine Familie mit applikations-spezifischen 16-Bit-Mikrocontrollern, die gegenüber alternativen Lösungen Kosteneinsparungen von bis zu 30 Prozent ermöglichen.

Kommunikation

- Im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 haben Infineon, Samsung Electronics, Trolltech und Emuzed das weltweit erste Referenzdesign für UMTS/EDGE-Smartphones auf Basis des Betriebssystems Linux gezeigt.
- Infineon hat die Musterverfügbarkeit des SMARTi PM, des industrieweit ersten Ein-Chip CMOS-Hochfrequenz-Transceivers für GSM-, GPRS- und EDGE-Mobiltelefone, angekündigt. Der SMARTi PM benötigt 50 Prozent weniger Leiterplattenfläche und reduziert verglichen mit bisherigen Lösungen die Systemkosten für den Hochfrequenzteil um 30 Prozent.
- Im Bereich drahtgebundene Kommunikation hat Infineon mit GEMINAX Pro den weltweit kleinsten und wirtschaftlichsten Chip für den Breitbandstandard ADSL2+ vorgestellt. In ADSL2+ sieht das Unternehmen mittelfristig die dominierende Zugangstechnologie. Der Chip setzt neue Maßstäbe, indem er den Stromverbrauch, den Platzbedarf und die Systemkosten um bis zu 30 Prozent reduziert.

Speicherprodukte

- Die Einführung der 90-Nanometer-Trench-Technologie für DRAMs auf 300-Millimeter-Wafern läuft planmäßig. Der Geschäftsbereich plant den Hochlauf der Produktion für Mitte 2005.
- Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2005 hat Infineon den Anteil von Produkten mit höherer Speicherkapazität weiter gesteigert und weitere innovative Produkte in sein Portfolio aufgenommen. Das Unternehmen hat auch erste Muster von 512 Megabit GDDR3 Graphics RAM Speicherbausteinen hergestellt.
- Als erstes Unternehmen der Branche hat Infineon 4 Gigabyte DDR2-Module auf Basis der Dual-Die-Technologie für Serverapplikationen vorgestellt. Diese Technologie ermöglicht das Stapeln von zwei identischen Chips in einem Gehäuse, wodurch sich die Dichte verdoppeln lässt, ohne die Gehäuseabmessungen wesentlich zu vergrößern. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für bestimmte Einsatzbereiche, bei denen Platzbedarf und Luftzirkulation von größter Bedeutung sind, z. B. Server und Notebooks.